

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2007-172818

(P2007-172818A)

(43) 公開日 平成19年7月5日(2007.7.5)

(51) Int.CI.

F 1

テーマコード(参考)

G 11 B 20/18 (2006.01)
H 03 M 13/15 (2006.01)
H 03 M 13/29 (2006.01)

G 11 B 20/18 532 E
H 03 M 13/15
H 03 M 13/29
G 11 B 20/18 512 C
G 11 B 20/18 572 G

5 J 065

審査請求 未請求 請求項の数 30 O L (全 29 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2006-341788 (P2006-341788)
(22) 出願日 平成18年12月19日 (2006.12.19)
(31) 優先権主張番号 11/313,438
(32) 優先日 平成17年12月20日 (2005.12.20)
(33) 優先権主張国 米国(US)

(71) 出願人 591179352
クウォンタム・コーポレイション
QUANTUM CORPORATION
アメリカ合衆国、95110 カリフォルニア州、サン・ノゼ、テクノロジー・ドライブ、1650、スイート・800
(74) 代理人 100064746
弁理士 深見 久郎
(74) 代理人 100085132
弁理士 森田 俊雄
(74) 代理人 100083703
弁理士 仲村 義平
(74) 代理人 100096781
弁理士 堀井 豊

最終頁に続く

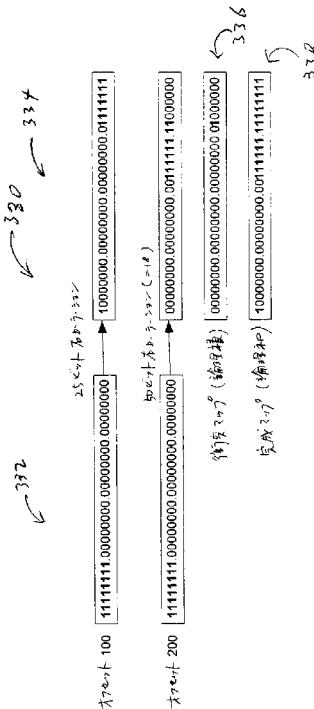
(54) 【発明の名称】 インタリープされたパリティチェックおよびリードソロモン符号を用いる誤り訂正アルゴリズム

(57) 【要約】

【課題】データストリームの誤りを訂正するための方法および装置を提供する。

【解決手段】1つの局面では、誤り訂正プロセスは、少なくとも2つの別個の種類のデータストリームの誤りを訂正するよう作動可能であり、それぞれは異なった誤り訂正スキームを利用する。誤り訂正プロセスは、誤り訂正についてリードソロモン符号および誤り検出符号(E DC)の組合せを利用する。このプロセスは、複数のデータブロックの誤りを特定して誤りを訂正するよう試みるために、リードソロモン符号を用いるステップを含む。するとE DCマップが生成され、このE DCマップは、リードソロモン符号によって訂正されない誤りを含む、対応するデータブロック内の誤りの位置を特定する。

【選択図】図30



【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

複数の誤り検出符号（E D C）を含む、符号化されたデータのストリームを受取るよう
に作動可能な誤り訂正装置であって、前記誤り訂正装置は、

符号化されたデータの前記ストリームに由来する二次元データアレイの第1の次元の誤
りを検出するために前記複数のE D Cを用いるよう、かつ前記二次元データアレイの第2
の次元の符号語を訂正するためにリードソロモン符号を用いるよう作動可能なデコーダを
含み、前記デコーダはさらに、リードソロモン符号からE D Cのうちの少なくとも1つ
中の対応するビットへ符号語をマッピングするよう作動可能である、誤り訂正装置。

【請求項 2】

前記リードソロモン符号の記号サイズは、前記E D Cのうちの少なくとも1つの記号サ
イズよりも小さい、請求項1に記載の誤り訂正装置。

【請求項 3】

前記誤り訂正装置はコントローラの一部として構成され、前記コントローラは、データ
記憶媒体に記録されたデータを検出するためのトランスデューサに結合される、請求項1
に記載の誤り訂正装置。

【請求項 4】

前記トランスデューサは磁気テープドライブヘッドを含み、前記データ記憶媒体は磁気
テープを含む、請求項3に記載の誤り訂正装置。

【請求項 5】

前記データ記憶媒体は、光ディスク、磁気ディスク、光学テープ、および磁気テープか
らなる群から選択される、請求項2に記載の誤り訂正装置。

【請求項 6】

前記E D Cのうち少なくとも1つは、 $g(x) = x^n + 1$ の形を有する原始多項式によ
って記述され、ここでnはE D C記号内のビット数である、請求項1に記載の誤り訂正装置。

【請求項 7】

前記E D Cの生成多項式は $G(x) = x + s$ の形を有し、ここでsは前記原始多項式
の根であり、sは0からn-1のいずれかの整数である、請求項6に記載の誤り訂正装置
。

【請求項 8】

前記デコーダは、前記リードソロモン符号からE D C残余へ前記符号語を関連付ける
ためのE D Cマップを生成するよう作動可能であり、前記E D Cマップは、前記リードソロ
モン符号語内の変化する記号により影響を受け得る前記E D C残余内の前記ビットについ
ては2進法の1、および他の全てのビットについては2進法の0から構成される、請求項
1に記載の誤り訂正装置。

【請求項 9】

前記E D Cマップは、巡回ビットローテーションまたは他のマッピング演算を実行する
ことによって正規化され、そのためビットマスク内の前記ビットは前記E D C残余内の対
応するビットに直接マッピングする、請求項8に記載の誤り訂正装置。

【請求項 10】

前記デコーダはE D Cマップを用いるように作動可能であり、訂正不能または信頼でき
ないように訂正されたと判断された顕著なリードソロモン符号語について誤りパターンを
判断するよう構成される、請求項1に記載の誤り訂正装置。

【請求項 11】

2つ以上のE D Cマップが生成され、全ての前記E D Cマップのビットワイズの論理和
が用いられて、全ての前記顕著なリードソロモン符号語によって影響を受ける前記E D C
残余内の前記ビットを決定する、請求項9に記載の誤り訂正装置。

【請求項 12】

2つ以上のE D Cマップが生成され、前記E D Cマップ内でビットワイズの論理積およ

10

20

30

40

50

び論理和演算が用いられて、2つ以上のリードソロモン符号語が前記E D C 残余内で同じビットに影響を及ぼすことができるか否かを判断する、請求項9に記載の誤り訂正装置。

【請求項13】

前記複数のE D C からの第2のE D C は誤り検出のためにのみ用いられ、前記複数のE D C からの第1のE D C からの訂正が信頼できるか否かを判断することができる、請求項1に記載の誤り訂正装置。

【請求項14】

前記第2のE D C は巡回冗長検査(C R C)を含む、請求項13に記載の誤り訂正装置。

【請求項15】

前記第2のE D C はリードソロモン符号を含む、請求項13に記載の誤り訂正装置。

【請求項16】

データ誤り訂正の方法であって、複数のデータブロックにおける誤りを特定して前記誤りを訂正するよう試みるためにリードソロモン符号を用いるステップと、

前記データブロックのいずれかに誤りがあるか否かを判断するために巡回冗長検査を用いるステップと、

前記リードソロモン符号によって訂正されない前記データブロックの誤りを訂正するために各データブロックの誤り検出符号(E D C)を用いるステップとを含む、方法。

【請求項17】

誤りを訂正するために各データブロックのE D C を用いる前記ステップは、E D C マップを生成するステップをさらに含み、前記E D C マップは、前記リードソロモン符号によって訂正されない誤りを含む対応するデータブロック内の前記誤りの前記位置を特定する、請求項16に記載の方法。

【請求項18】

誤りを訂正するために各データブロックのE D C を用いる前記ステップは、前記リードソロモン符号によって訂正されない前記データブロックの少なくとも1つの誤りを訂正するために、前記E D C から生成されるマップを用いるステップをさらに含む、請求項16に記載の方法。

【請求項19】

E D C マップを生成する前記ステップは、各顯著なリードソロモン符号語について1組のE D C マップを生成するステップを含み、前記E D C マップは、前記リードソロモン符号語内の変化する記号により影響を受け得る前記E D C 残余内の前記ビットについては2進法の1、および、マッピング演算を実行することによって前記E D C マップを正規化する他の全てのビットについては2進法の0から構成され、そのため、前記ビットマスク内の前記ビットは前記E D C 残余内の対応するビットに直接マッピングする、請求項17に記載の方法。

【請求項20】

前記マッピング演算は、巡回ビットローテーションを含む、請求項19に記載の方法。

【請求項21】

前記E D C の少なくとも1つは、 $g(x) = x^n + 1$ の形を有する原始多項式によって記述され、ここでnはE D C 記号内のビット数である、請求項18に記載の方法。

【請求項22】

前記E D C の生成多項式は $G(x) = x + s$ の形を有し、ここでsは前記原始多項式の根であり、sは0からn-1のいずれかの整数である、請求項21に記載の方法。

【請求項23】

請求項18に記載の前記方法を実行するよう作動可能な、テープドライブ。

【請求項24】

テープドライブであって、磁気テープ上のデータを読取るよう作動可能な磁気テープドライブヘッドを含み、前記

10

20

30

40

50

データは複数のデータブロックを含み、

前記磁気テープドライブヘッドに電気的に接続されるコントローラを含み、前記コントローラは、前記データの誤りを訂正するために各データブロックの誤り訂正符号（ECC）フィールドを用いるよう作動可能であり、前記コントローラはさらに、前記各データブロックの誤りについて検査する際に前記各データブロックの巡回冗長検査（CRC）フィールドを用いるよう作動可能である、テープドライブ。

【請求項 25】

前記データブロックの各々は、ECCフィールドまたはCRCフィールドのいずれかを有し、前記ECCフィールドおよび前記CRCフィールドは前記データブロックにおいて同じ位置を占め、前記コントローラはさらに前記データブロックの誤りを訂正するためにEDCフィールドを用いるよう作動可能である、請求項24に記載のテープドライブ。 10

【請求項 26】

前記コントローラはさらに、各データブロックの前記EDCフィールドに基づいてマップを生成するよう作動可能であり、前記マップは、前記対応するデータブロックにおいて誤りの前記位置を特定するために前記コントローラによって用いられるよう構成される、請求項25に記載のテープドライブ。

【請求項 27】

前記コントローラは、前記複数のデータブロックにおいて誤りを訂正するためにリードソロモン符号を用いるよう作動可能であり、前記コントローラはさらに、前記リードソロモン符号からEDC残余へ符号語を関連付けるためのEDCマップを生成するよう作動可能である、請求項25に記載のテープドライブ。 20

【請求項 28】

前記EDCマップは、前記リードソロモン符号語内の変化する記号により影響を受け得る前記EDC残余内の前記ビットについては2進法の1、および他の全てのビットについては2進法の0から構成される、請求項27に記載のテープドライブ。

【請求項 29】

磁気テープドライブであって、
複数のデータブロックの誤りを特定して前記誤りを訂正するよう試みるためにリードソロモン符号を用いるよう、前記データブロックのいずれかに誤りがあるか否かを判断するために巡回冗長検査を用いるよう、かつ、前記リードソロモン符号によって訂正されない前記データブロックの誤りを訂正するために各データブロックのEDCを用いるよう作動可能なコントローラを含み、前記コントローラはさらにEDCマップを生成するよう作動可能であり、前記EDCマップは、前記リードソロモン符号によって訂正されない前記対応するデータブロック内の前記誤りの前記位置を特定するために前記コントローラによって用いられる、磁気テープドライブ。 30

【請求項 30】

前記コントローラはさらに、前記リードソロモン符号によって訂正されない前記データブロックの少なくとも1つの誤りを訂正するために、前記EDCから生成されるマップを用いるよう作動可能である、請求項29に記載の磁気テープドライブ。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

技術分野

本発明は、一般に誤り訂正符号の分野に関する。本発明の一局面において、本願明細書で開示される機器および方法は、磁気テープドライブにおいて実現することができる。

【背景技術】

【0002】

背景

データ記憶媒体に記憶されるデータの密度が増加するにつれて、媒体に記憶されたデータの完全性を確認し、書き込みおよび／または読み取りプロセス中に起こり得る誤りを訂正す 50

るために、より高度な誤り訂正方法が必要である。加えて、データ記憶装置がより小さくなり、より速い速度で作動するにつれて、データ記憶媒体からデータを読取る際の誤り率も増加する。

【0003】

例えば、より小さい読み取り装置を有する改良されたテープドライブが古い世代の磁気テープを読み取るために利用されると、読み取り装置の寸法がより小さく、および／または作動速度がより速いために、誤り率が著しく高まり得る。加えて、古い世代のテープは、より新しい世代のテープよりもさらに原始的な誤り訂正符号を利用していることがある。その結果、新世代のテープドライブは、古い世代のテープと後方互換性がないことがある。

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

したがって、新世代の誤り訂正符号を実現すると同時に、古いフォーマットで保存されたデータが新世代のシステムによって検索されて利用されるよう、古い世代の誤り訂正符号を活用することができる、誤り訂正プロセスが必要とされる。

【課題を解決するための手段】

【0005】

発明の概要

データストリームの誤りを訂正するための方法および機器が、本願明細書において記載される。一つの局面では、誤り訂正装置は、少なくとも2つの別個の種類のデータストリームにおける誤りを訂正するように作動可能であり、各々は異なった誤り訂正スキームを用いる。一例において、誤り訂正装置は、複数の誤り検出符号（E D C）を含む、符号化されたデータのストリームを受取るように作動可能であり、この誤り訂正装置は、符号化されたデータのストリームから構成される2つの二次元データアレイの、第1の次元の誤りを検出するために複数のE D Cを用いるように、かつ、この2つの二次元データアレイの第2の次元の符号語を訂正するためにリードソロモン符号を用いるように作動可能なデコーダを含む。コントローラはさらに、リードソロモン符号から1つ以上のE D C内の対応するビットへ符号語をマッピングするよう作動可能である。1つの変形例において、リードソロモン符号の記号サイズは、E D Cの少なくとも1つの記号サイズよりも小さい。別の変形例において、誤り訂正装置はコントローラの一部として構成される。コントローラは、データ記憶媒体に記録されたデータを検出するためのトランステューサに結合される。1つの特定の適用例において、トランステューサは磁気テープドライブヘッド（例えば磁気抵抗型テープヘッド）を含み、データ記憶媒体は磁気テープを含む。他の適用例において、誤り訂正装置は、光ディスク、磁気ディスクまたは光学テープから読み取られたデータを処理するよう構成され得る。

【0006】

一実現例では、デコーダは、符号語をリードソロモン符号からE D C残余に関連付けるためのE D Cマップを生成するように作動可能であり、E D Cマップは、リードソロモン符号語内の変化する記号により影響を受け得るE D C残余内のビットについては2進法の1、および他の全てのビットについては2進法の0から構成される。E D Cマップは、巡回ビットローテーションまたは他のマッピング演算を実行することにより正規化され、その結果、ビットマスク内のビットがE D C残余内の対応するビットに直接マッピングする。1つの変形例において、2つ以上のE D Cマップが生成され、全てのE D Cマップのビットワイズ論理和が用いられて、全ての顕著なリードソロモン符号語によって影響を受けるE D C残余のビットを決定する。別の変形例において、2つ以上のE D Cマップが生成され、E D Cマップ内でビットワイズ論理積演算および論理和演算が用いられて、2つ以上のリードソロモン符号語がE D C残余内の同じビットに影響を及ぼすことができるか否かを決定する。

【0007】

いくつかの変形例においては、E D Cのうち少なくとも1つは、 $g(x) = x^n + 1$ の形

を有する原始多項式によって記述され、ここで n は EDC 記号内のビット数である。EDC の生成多項式は $G(X) = X + \alpha^s$ の形をとることができ、ここで α は原始多項式の根であって、 s は 0 から $n - 1$ のいずれかの整数である。

【0008】

別の局面においては、リードソロモン符号および EDC を用いた誤り訂正のための方法が記載される。一例において、その方法は、複数のデータブロックにおける誤りを特定して誤りを訂正するよう試みるためにリードソロモン符号を用いるステップと、データブロックのいずれかに誤りがあるか否かを判断するために巡回冗長検査を用いるステップと、リードソロモン符号によって訂正されないデータブロックの誤りを訂正するために各データブロックの誤り検出符号 (EDC) を用いるステップとを含む。誤りを訂正するため各データブロックの EDC を用いるためには、EDC マップが生成され、EDC マップは、リードソロモン符号によって訂正されない誤りを含む、対応するデータブロック内の誤りの位置を特定する。

【0009】

1つの変形例において、EDC マップは、各顕著なリードソロモン符号語について一組の EDC マップを作成することによって生成され、EDC マップは、リードソロモン符号語内の変化する記号により影響を受け得る EDC 残余内のビットについては 2 進法の 1、および他の全てのビットについては 2 進法の 0 から構成される。EDC マップは次にマッピング演算を実行することによって正規化され、その結果、ビットマスク内のビットは EDC 残余内の対応するビットに直接マッピングする。一例において、マッピング演算は巡回ビットローテーションを含む。

【0010】

本発明のこれらの、および他の実施例、特徴および利点は、添付の簡単に説明される図面と関連して下記の本発明のより詳細な説明を考慮すると、当業者にはより明らかになるであろう。

【発明を実施するための最良の形態】

【0011】

発明の詳細な説明

下記の詳細な説明は図面を参照して読まれるべきであり、同一の参照番号は異なる図面の全体にわたって同様の要素を指す。図面は必ずしも縮尺通りではないが、選択的な実施例を表し、本発明の範囲を限定することを意図しない。詳細な説明は、例として、限定するためではなく、本発明の原理を示す。この説明は明らかに、当業者が本発明を行い、使用することを可能にし、本発明を実施する最良の形態であると現在考えられるものを含む、本発明のいくつかの実施例、適合、変形例、代替および使用例を記載する。

【0012】

本願明細書においては、本発明のさまざまな局面を示すため、本願明細書において開示される誤り訂正方法および装置を用いるための適用例として磁気テープドライブが用いられる。当業者は、本願明細書における開示に照らし、本願明細書に開示される方法および機器が、データ記憶媒体から検索されるデータの完全性を確実にするために誤り訂正符号 (ECC) を用いる、さまざまなメモリ記憶コンポーネントまたはデータ転送装置において実現され得ることを理解する。例えば、本願明細書に開示される方法および機器は、データ確認および保護を与えるために、さまざまな他のデータ記憶システム（例えばハードディスク、光学ドライブなど）で実現されることもできる。別の例では、データバッファリングプロセスにおいて ECC を実行するネットワークルータが、効率的な ECC 利用を達成するために、本願明細書に開示される方法および機器を活用してもよい。さらに別の例において、本願明細書に開示される方法および機器は、記憶媒体から検索されるデータを検査して訂正するために、メモリコントローラにおいて用いられ得る。この方法および機器はまた、2つ以上のデータ符号化フォーマットがデータ記憶システムによってサポートされるよう、後方互換性を与えるように構成されてもよい。

【0013】

10

20

30

40

50

この明細書および添付の請求の範囲において用いられているように、単数形 ("a", "an", "the") は、文脈が明らかに逆を示す場合以外は、複数の指示対象をも含むことにも注意されなければならない。したがって、例えば、「トランスデューサ (a transducer)」は単一のトランスデューサまたはトランスデューサの組合せを意味するよう意図され、「電気信号 (an electrical signal)」は 1 つ以上の電気信号またはその変調を意味するよう意図される。加えて、本願明細書において用いられる EDC は、EDC 残余、冗長ブロック、パリティブロック、当業者に周知の誤り検出符号の変形例、およびそれらの改良を含むが、これらに限定されない。本願明細書において用いられるリードソロモン符号は、標準リードソロモン符号、当業者に周知のリードソロモン符号の変形例、およびそれらの改良を含む。

10

【0014】

図 1 を参照すると、1 つの適用例において、誤り訂正装置 10 は、磁気テープから読取られたデータストリームの誤りを訂正するための、磁気テープドライブ 14 内のコントローラ 12 の一部として実現される。誤り訂正装置は、誤り訂正アルゴリズムを実行するよう作動可能なデコーダを含む。磁気テープドライブヘッド 18 は磁気テープ上のデータを読取るよう作動可能であり、データは複数のデータブロックを含む。コントローラは磁気テープドライブヘッド 18 に電気的に接続され、コントローラは、データの誤りを訂正するために、各データブロックにおいて誤り訂正符号 (ECC) フィールドを使用するよう作動可能である。1 つの構成において、コントローラは、各データブロックの誤りを検査するために、データブロックの各々において巡回冗長検査 (CRC) フィールドを用いるよう作動可能である。

20

【0015】

1 つの変形例において、誤り訂正装置は、2 つの個別のフォーマット（例えば、一方は ECC フィールドを含む符号化スキームを用いて書込まれ、他方は CRC フィールドを含む符号化スキームを用いて書込まれた、2 つの磁気データ記憶テープ）に保存されたデータを復号化するよう構成され、データブロックは、ECC フィールドまたは CRC フィールドのいずれかを有し、ECC フィールドおよび CRC フィールドはデータブロックにおいて同じ位置を占める。コントローラは、データブロックの誤りを訂正するために EDC フィールドを用いるよう、さらに作動可能である。1 つの変形例において、コントローラは、各データブロックにおいて EDC フィールドに基づいてマップを生成するよう作動可能であり、マップは、対応するデータブロックにおいて誤りの位置を特定するためにコントローラによって用いられるよう構成される。一例において、コントローラは、複数のデータブロックにおいて誤りを訂正するためにリードソロモン符号を用いるよう、かつリードソロモン符号から EDC 残余へ符号語を関連付けるための EDC マップを生成するよう作動可能である。一実現例では、EDC マップは、リードソロモン符号語内の変化する記号により影響を受け得る EDC 残余内のビットについては 2 進法の 1、および他の全てのビットについては 2 進法の 0 から構成される。

30

【0016】

典型的な誤り訂正プロセスが下記に示される。この例では、誤り訂正プロセスはテープドライブのコントローラで実現される。より強力な形の誤り訂正プロセス（すなわち二次元のリードソロモン符号）が用いられ、それによりテープドライブは、従来のテープドライブの多くと比較してより高性能点で作動することが可能になる一方、より高いビット誤り率を有する媒体を許容することとなる。この誤り訂正プロセスは、古い世代のテープドライブより小さな読み取り装置の使用が可能になる一方で、例えば CRC で符号化されたものなど以前のフォーマットで書込まれたテープの読み取りをも可能にする。

40

【0017】

この例で用いられる ECC は二次元の符号であって、積符号と呼ばれる。第 1 の次元はブロックであり、誤り検出または誤り訂正については、64 ビットの CRC、または 16 ビットのリードソロモン符号を用いる。第 2 の次元はエンティティであり、一群のデータブロックおよび ECC ブロックを含む。テープドライブは、データをテープに書込む際に

50

エンベロープと呼ばれる構成を用い、その目的は全てのチャンネルにわたってエンティティをインタリープし、そのため境界のチャンネルへの露出を最小化することである。テープドライブがホストからデータのストリームを受取るときに、テープドライブのメモリコントローラは、このデータをデータブロックと呼ばれる基本単位に入れる。デコーダのECCエンジンは次に、破損した、または失われたあらゆるデータブロックの再建を助けるECCブロックを生成する。

【0018】

データブロックは、さまざまな制御フィールドにユーザデータを含む。この例示的なテープドライブのブロックのレイアウト 20 の概要が図 2 に示される。テープドライブは、ホストから受取る情報を用いて各データブロックのユーザデータ 22 セクションを生成する。ユーザデータセクションに続くのは、EDC（誤り検出符号）フィールド 24 である。これは、前のユーザデータ領域のチェックサムを含む、32ビットのフィールドである。訂正アルゴリズムは訂正確認のために EDC を用い、またブロックデータ自体を訂正するために用いられてもよい。EDC を計算するためにドライブによって用いられるアルゴリズム 30 が図 3 に示される。EDC を確認することは、同じアルゴリズムを実行することであるが、EDC フィールドを通して続けることである。これは残余を生成する。残余がゼロである場合、EDC 検査は成功したことになる。残余が非ゼロである場合、ブロックのいずれかの部分が破損を含む。

【0019】

CF1（制御フィールド 1）26 は 16 バイト長であって、このブロックを論理的に特定するのに用いられ得る情報を含む。CF2（制御フィールド 2）28 は、テープ上および誤り訂正構成内での物理的な位置を特定するのに用いられ得る情報を含む。これは、このブロック内の欠陥を訂正するために用いられる冗長情報を含む、64 バイトのフィールドである。ハードウェアはこのデータがテープへ出ていくに従って、これをブロックに追加する。訂正ハードウェアは、ブロックを訂正するためにこれらのバイトを使用した後、読み取り動作中にバイトを取除く。ECC1 ハードウェアは、ブロック内で最大 16 の破損記号を訂正することができる。この場合、各記号は 16 ビット幅である。ECC2 ハードウェア（REC と呼ばれる）は、一組のデータブロックを受けて冗長情報を生成する。REC ハードウェアは、「部分シンドローム生成を伴うセルを用いた誤り訂正デコーダ（Error Correction Decoder Using Cells with Partial Syndrome Generation）」と題されて 2005 年 8 月 25 日に公開された、米国特許出願公開番号第 2005 / 0188293 A1 号において詳細に記述され、本願明細書においてその全体が引用にて援用される。この新しく生成されたブロックは ECC ブロック 40 であり、その唯一の目的はあらゆる破損したデータを訂正するのを助けることである。そのフォーマットは図 4 に示される。ECC2 ブロックのための CF2_42 および ECC1_44 のフィールドは、データブロックのためのそれらと同じである。

【0020】

この例において、全ての逆読みフォーマットについてのブロックレイアウトは、64 ビットの CRC が ECC1 フィールド 29 を置換することを除いては、クウォンタム（Quantum）DLT-S4 テープドライブのネイティブフォーマットのそれと実質的に同じである。CRC は誤り検出を実行できるだけであって訂正能力はない。このテープドライブの例示的な誤り訂正プロセスにもサポートされる、古いフォーマットのデータ 50 および ECC52 ブロックの両方のレイアウトが図 5 に示される。

【0021】

クウォンタム DLT-S4 の ECC2 アルゴリズムは、エンティティと呼ばれている構成を用いることにより、ブロック全体の誤りから保護する。エンティティは、破損したデータブロックを再建するために用いられる 16 個の ECC ブロックを伴った、1 個から 112 個のデータブロックの集合である。エンティティ 60 のレイアウトは図 6 に示される。ラベル「符号語」を有する縦の長方形に注意されたい。各エンティティはこれらの符号語を 12, 288 個含み、それらは最も左側から CF1 の端部まで延々と及ぶ。CF2 フ

10

20

30

40

50

フィールドおよびCRC（またはECC1）フィールドは含まれない。各符号語は、エンティティ内の各ブロックから1つの記号（この文脈ではバイト）を含む。この例では、符号語は全てのブロック内で同じオフセットにある記号の集合である。ECC2アルゴリズムは、訂正動作を実行する際、符号語を独立に処理する。

【0022】

市販のテープドライブにおいて実現される、以前のフォーマット（例えばクウォンタムSDLT320、クウォンタムSDLT600）は、ブロック数が少ないことを除いては、同じ基本エンティティレイアウトを用いる。特に、1個から16個のデータブロックおよび4個のECCブロックを含む、逆読み互換性（BRC）フォーマットである。テープ上のこの相対的なブロックのレイアウトについては後述する。データを書込む際、このテープドライブはエンベロープと呼ばれる基本単位を用いる。エンベロープは、散乱パターンの全てのチャンネルにわたってインタリープされた、1個から8個のエンティティを含む。テープドライブは、ストライプごとにエンベロープを書込む。ストライプは、全てのチャンネルによって同時に書かれた、ブロックの縦のグループである。この例示的なドライブを用いて磁気テープ上に書込まれたエンベロープ72の例示的レイアウトが図7に示される。各長方形はテープ上のブロックを表す。陰影をつけられた長方形は、第1のエンティティのための散乱パターンを示す。他の7個のエンティティの各々は同じパターンを有するが、開始位置は異なる。名目上のエンベロープは8個のエンティティを保持し、64個のストライプに及ぶ。

【0023】

古いフォーマットのエンベロープのレイアウト82の例が図8に示される。この例は、クウォンタムSDLT600テープドライブにおいて利用されるフォーマットを示す。この特定のフォーマットは、結合されたチャネル（coupled channel）の概念を用い、これは、以前の製品と同じ数の論理チャネルを保つ一方でテープ上の物理チャネル数を倍にする、簡単なやり方である。各エンベロープは8個のエンティティを含み、最大サイズのエンティティは20個（16個のデータおよび4個のECC）のブロックを含む。この例示的なテープドライブにサポートされる別のフォーマット（すなわちクウォンタムSDLT220/320）が図9に示される。SDLT220/320フォーマットはECMA仕様（ECMA-320）として公開される。図9において、エンベロープ92の各々は、名目上、20個のストライプおよび8個のエンティティを含む。

【0024】

誤り訂正プロセスは、読み取りプロセスのサブセットである。読み取りプロセス100を示すフローチャートが図10に示される。ドライブはいくつかのデータを読み取る。データが不良な場合、ドライブはその訂正を試みる。訂正が失敗した場合、ドライブはヘッドを再位置決めし、データを再度読み取ることを試みる。これがあまりに何度も起ると、ドライブは断念し、読み取り困難な誤り（Hard Read Error）（HRE）信号を出す。訂正プロセス110の概要を示すダイヤグラムが図11に示される。

【0025】

訂正プロセスは、3つの基本アルゴリズムから選択する。消失訂正（Erasure Correction）、拡大訂正（Extended Correction）および全数訂正（Exhaustive Correction）である。拡大訂正および全数訂正は、別の「反復」を実行する能力を有する。これは、訂正アルゴリズムがいくつかのデータを回復したが、残るデータを得るために別の訂正を試みる必要がある場合に該当する。

【0026】

訂正プロセスの第1のステップは、「訂正タイプの決定」120である。図12はこのプロセスを概説する。このアルゴリズムは、問題のエンティティを調べることによって開始し、失われたブロックの個数（消失数）、部分的に回復されたブロックの個数（ECC1またはCRCが不良だがそれ以外は良い）、および良いブロックの個数を決定する。数量TotalBadは、消失したブロックおよび部分的に回復されたブロック（すなわち

10

20

30

40

50

良くないもののすべて)の和である。Total BadがこのフォーマットからのECCブロックの最大個数より少ないかまたはこれと等しい場合、次に装置は、最適化されたエンティティ消失訂正(Entitiy Erasure Correction)を用いることができる。特例として、装置は少なくとも1つの不良なデータブロックがあることを再確認する。そうでない場合には、訂正を実行する必要はない。Total BadがECCブロックの最大個数より多い場合は、装置は拡大訂正アルゴリズムを用いる必要がある。これは、消失した(すなわち完全に失われた)ブロックの個数(ErasreCnt)がECCブロックの最大個数より少ない場合にのみ可能である。一実現例では、あまりに多くの消失がある場合、訂正がうまく実行され得ないために、装置は訂正プロセスを中止する。

10

【0027】

全ての訂正アルゴリズムにおいて最も基本となるのは、エンティティ消失訂正アルゴリズムである。このアルゴリズムは、最大でも16個の破損ブロック(またはいくつかの市販のテープドライブにおいて実現されたいくつかの以前のフォーマットであれば最大でも4個)がある場合に有効であり得る。この例において、装置は既知の値と同程度に未知の値を有する、1組の単純な線形方程式を有する。ECC2ハードウェア補助(REC)は、これらの線形方程式を解くためにマトリクス乗算演算を高速で実行することができる。訂正プロセスは、訂正マトリクスを生成し、失われたデータブロックを訂正するのにハードウェアがこのマトリクスを用いるようにプログラムすることを含む。

20

【0028】

消失訂正を実行する一方で、ハードウェアは、新しく生成される全てのブロックにEDC検査を実行する。訂正が終わると、ファームウェアが、新しく生成された各データブロックのEDC残余を検査する。EDC検査により、いずれかのデータブロックが誤りを有することが示された場合、消失訂正アルゴリズムは失敗し、誤りはエンティティが訂正可能でないことを示す。図13は、消失訂正130の全プロセスを示す図である。

30

【0029】

拡大訂正アルゴリズム(部分的訂正としても知られる)は、比較的多数の部分的に回復されたブロック(不良なECC1またはCRC64を有するもの)を含むエンティティを訂正することができる。各符号語の有する誤りがシンドロームの半数より少ない場合、このアルゴリズムは成功する。1つの変形例において、標準リードソロモン誤り訂正アルゴリズムが実現されて拡大訂正を実行する。いくつかの状況においては、拡大訂正アルゴリズムはエンティティを訂正することができないが、消失訂正アルゴリズムが仕上げることは可能である。この場合、拡大訂正は、装置が別の反復を試みるべきであることを示す結果を返す。さらに他の場合において、拡大訂正が別の反復を直接試みることができないことは明らかである。これらの場合、全数訂正プロセスが実行される。拡大訂正プロセス140全体を示すダイヤグラムは図14において示される。

40

【0030】

全数訂正アルゴリズムは、全数的に訂正組合せを試みることによってエンティティを訂正することを試み、次にCRC64検査を用いて訂正を確認する。全数訂正アルゴリズム150のフローチャートは図15に示される。このプロセスは、図11の「全数訂正を試みる」112とラベルをつけられたボックスに対応する。

【0031】

第1のボックス「全数訂正のための設定」152は、全数訂正の試行を始める前に必要な、あらゆる1回限りの計算のためである。これらの計算は主に機能強化のためである。最後のボックスは、他のアルゴリズムがいずれかのECCブロックを訂正したか否かを見る最終検査である。

【0032】

全体として、プロセスは特定のアルゴリズムを試み、なんらかの良いCRC結果があるかを検査するものである。良いCRC検査がある場合、次に反復的な訂正(十分な良いCRC検査がある場合)、または、良いCRC検査をさらに生成しようとして初めにアルゴ

50

リズムを再開する。アルゴリズムのいずれもが良い C R C 検査を生成することができない場合、全数訂正アルゴリズムは失敗する。失敗の後、装置は再位置決めの再試行を実行するか、または読み取り困難な誤り(H R E)を報告する必要がある。

【 0 0 3 3 】

図 15 の第 2 の ボックス 154 は、いずれかの信頼できる符号語の訂正を試みるアルゴリズムのためのボックスである。全体として、このアルゴリズムは、 E D C を用いて、 E D C 衝突のない符号語を訂正する。このアルゴリズム 160 は、図 16 に概説されるステップを含む。このアルゴリズムの第 1 のステップ 162 は、信頼できない符号語のリストを点検し、いずれかの訂正されたブロックの C R C を装置がうまく確認した場合には、これらを良いとしてマークすることになる。このステップは、有効なブロックを生じた訂正のいずれかの部分に見える場合、信頼できない符号語を信頼できる符号語に発展させている。この符号語が正しくないかもしれないという可能性は依然としてあるが、その確率は、目標とする訂正不能な誤り率よりも、十分低い。前のステップにおいて信頼できない符号語を発展させた後、装置は次に各ブロックの E D C 残余を用いていずれかの信頼できる領域を訂正する。信頼できる領域は、他のいかなる信頼できない、または訂正できない符号語とも衝突を有しない、 32 ビット語の一部である。装置はこれらの場合には、 E D C 残余内の不良な符号語と領域との、信頼できる 1 対 1 のマッピングを有する。装置は、取消し(undo)情報を保つことについて懸念することなく、これらの変更を適用することができる。

【 0 0 3 4 】

このアルゴリズムは各符号語を調べ、それが衝突を有しないか、部分的な衝突を有するか、完全な衝突を有するかを判断する。衝突がない場合、装置は完全にこの符号語を訂正し、良いとしてマークすることができる。部分的な衝突がある場合、装置は衝突のない領域を訂正することができるが他のビットはそのまま放置する。装置はこの符号語を訂正不能な符号語としておいておく。完全な衝突がある場合、装置は符号語を完全にスキップする。このアルゴリズムでは、装置が衝突を有しない非ゼロの E D C ビットを見つけた場合には、いかなる信頼できない符号語も訂正不能な符号語になる。この場合、装置はこれが誤訂正であると仮定して、以前の訂正を取消す。

【 0 0 3 5 】

符号語の信頼できる部分の処理が、成功した訂正をいかに生成するかを示す例が下記に説明される。この例は既存のテープドライブフォーマット(すなわちクウォンタムテープドライブのチポトレ(C h i p o t l e)(S D L T 3 2 0) フォーマット)に書込まれたデータの処理を示す。図 17 に示すように、例としてのエンティティ 170 は、 2 つの消失した(完全に失われた) ブロック 9 および 10 を有する。ブロック 1 から 8 は、少なくとも 1 つの破損したバイトに起因する不良な C R C を有する。他の 10 のブロックは全て良い C R C を有し、シンドローム生成を除いては訂正に参加しない。

【 0 0 3 6 】

この例では、拡大訂正アルゴリズムは 7 個の破損した符号語を特定し、上記の図で A から F までラベル付けをした。符号語 B 、 C 、 D 、 E および G は全て 1 つの破損しか有さず、全て正しく訂正される。他の 2 つの符号語(A および F)は、 E C C 2 の訂正能力を超える。 2 つの消失は各々 1 つのシンドロームを燃焼させるので、誤り訂正に利用可能なのは元の 4 つのうち 2 つのシンドロームのみである。誤り訂正是 2 つのシンドロームを必要とするので、アルゴリズムの訂正の限界は 1 つの符号語につき 1 つの誤りとなる。符号語 A および F は、両方とも 2 つの誤りを有する。この説明の目的のため、拡大訂正アルゴリズムが符号語 A を訂正不能として特定したにもかかわらず、誤って訂正符号語 F を訂正したと仮定する。結果として生じるレイアウト 180 が図 18 に示される。

【 0 0 3 7 】

消失したブロック 9 および 10 はほぼ再生することに注意されたい。符号語が正しい場合、ブロック 9 および 10 の対応する領域もまた正しい。同様に、符号語が訂正不能であるかまたは誤って訂正された場合、 9 および 10 の対応する領域はこれを反映する。

10

20

30

40

50

【 0 0 3 8 】

拡大訂正アルゴリズムは、これら全ての符号語の位置をテーブルに記録する。符号語 A は訂正不能な符号語リストに入り、符号語 B から G は信頼できない符号語リストに入る。これらはすべて信頼できない。なぜならば、符号語 F の場合と同様、比較的高い確率で不良な訂正があるからである。実際この状況では、およそ 16 分の 1 の確率で誤訂正がある。

【 0 0 3 9 】

拡大訂正アルゴリズムは、完了後、全ての不良なブロックの EDC を検査する。前の図の右列は、不良な EDC 残余に X をつけて示し、良い残余に空の長方形をつけて示す。したがって、ブロック 4 から 8 のすべてが良い EDC 残余を有し、他のブロックは不良な残余を有する。この説明の目的のために、ブロック 4 から 8 において続く CRC 検査も良い残余（全零）という結果になると仮定できる。CF1 フィールドまたは CRC 検査バイト自体において問題が生じない限り、たいていこれが当てはまる。

【 0 0 4 0 】

この時点では、拡大訂正アルゴリズムは、5 個のブロック（1、2、3、9、10）が不良な EDC / CRC 検査を有することを発見している。これは、反復訂正アルゴリズムによって許容される 4 個のブロックの限界を超える。これにより全数訂正アルゴリズムに制御を転送する必要が生じる。全数訂正の第 1 のステップは、EDC 訂正を試みることである。

【 0 0 4 1 】

このアルゴリズムは、全ての信頼できない符号語（この場合は符号語 B から G である）を点検して、訂正されたバイトのいずれかが今や良い CRC 検査を有するブロックと一致するか否かを検査する。信頼できない符号語テーブル 190 が図 19 に示される。

【 0 0 4 2 】

ブロック 4 から 8 の全てが良い CRC 検査を有するので、これらの符号語のほとんどを信頼できないものから信頼できるものへと発展させることができる。事実、信頼できないままで残る唯一の符号語は符号語 F のみである。信頼できない符号語を確認した後のエンティティの状態を示すダイヤグラム 200 が図 20 に示される。符号語 A 202 は訂正不能であり、図 20 に示されるように、符号語 F 204 は信頼できない。

【 0 0 4 3 】

これらの 2 つの符号語が EDC 残余の異なる部分に影響を及ぼす（すなわちそれらが EDC マップにおいて衝突を有しない）確率は約 53% (17 / 32) である。この例については、これらの符号語が独立していると仮定することができる。符号語 A がオフセット 2 にあり、符号語 F はオフセット 100 にあると仮定する。結果として生じる符号語の EDC マップ 210 が図 21 に示される。結果として生じる衝突マップ 212 がゼロであることに注意されたい。これは、2 つの符号語が EDC 残余の独立領域に影響を及ぼすことを示す。次に 2 つの符号語に各ブロックの EDC 残余を安心して適用することができる。図 22 において、サンプルとしていくつかの誤りパターンが与えられ、これらのパターンがいかに EDC 残余 220 に影響を及ぼすかを示す。この例の全ての自然な誤りは誤りパターン「101」を有し、他の誤りはランダムである。

【 0 0 4 4 】

EDC 残余内のどのビットがどの符号語に対応するかが特定されたので、その後の訂正是これらの情報の関連付けの問題となる。アルゴリズムの 1 つの変形例は下記に与えられる：

- 1 全ての破損したブロックを通ってループする；
- 2 ブロック内の全ての破損した符号語を通ってループする；
- 3 現在のブロックおよび符号語については、EDC 残余と EDC マップとの間の論理積として訂正語を計算する；
- 4 訂正語と一致するビットを除去することによって EDC 残余を更新する；
- 5 訂正語をもとの符号語の位置にローテーションさせる；

10

20

30

40

50

6 キャッシュ内で訂正語と破損した語との間で排他的論理和演算を用いてリード - モデイファイ - ライトを実行する；

7 他の全ての符号語およびブロックを続ける。

例として、図 22 のブロック 1 内の破損および符号語 A へのアルゴリズム 230 の適用が図 23 に示される。

【0045】

最後のステップは、キャッシュに排他的論理和演算を実行することによってキャッシュ内のデータに最終訂正語を適用することである。全てのゼロビットはキャッシュデータを不变に保ち、1ビットがキャッシュデータを反転させる。全ての EDC 訂正を実行した後、最終ステップは、今や良い EDC 残余を有する（すなわち全零）いずれかのブロックの CRC を検査することである。上記の例は、EDC 訂正アルゴリズムが、EDC 残余からの情報を用いて、独立符号語を含むエンティティをいかに訂正することができるかを示す。次のセクションでは、従属符号語（すなわち非ゼロの衝突マップ）を有する場合をいかに扱うかを説明する。

【0046】

図 24 に示すように、あるアルゴリズムが与えられて、恐らく誤訂正であろう符号語を見つけ、次に訂正を取消す。しばしばこのステップは、良い CRC を有するブロックを生じる。このアルゴリズムは、信頼できない訂正が誤訂正であると仮定して、信頼できない符号語を訂正不能な符号語に変換することを試みる。その後、フローは次のアルゴリズム（すなわち訂正不能な符号語の試行）へと続き、その時点で、訂正不能な符号語を信頼できない符号語へ再び変換する試みが行われる。これらのアルゴリズムを 2 回以上試みるのが必要な状況があるので、図 15 のマスターフローはこれらの 2 つのアルゴリズムを 2 度含む。

【0047】

図 24 を参照すると、信頼できない符号語を試行するためのアルゴリズムが詳細に示される。このアルゴリズムの機能の 1 つは、誤訂正のための最良の候補を特定することである。1 つの変形例において、1 ブロックについて約 5 個から 20 個の信頼できないオフセットがある。大部分の訂正は、1 ビットまたは 2 ビットのいずれかである。これは自然に発生する誤りが典型的には 1 ビットのみであるという事実に起因し、アンプリコーダ（un-precoder）が、それをパターン 101 まで拡大する。欠陥がバイトの終わりまたは始まりに近い場合、第 2 のビットは 1 ビットの誤りを残してバイトの外側で拡大する。

【0048】

他方、誤訂正は、典型的にはランダムな 8 ビットパターンである。これは、8 ビットパターンのいずれかが有効な符号語を作る確率が均一に分散されているからである。有限体は合理的な疑似乱数を生成することができ、この場合、誤訂正は疑似乱数に類似する。

【0049】

このアルゴリズムは、最大数の 2 進法の 1 を含む、EDC 残余内でパターンと一致する訂正を検索することにより、最も信頼できない符号語を見つける。図 25 は、一様な乱数を仮定して、ある数のビットを得る確率 250 を示す。図 25 に示すように、乱数は 3、4 または 5 ビットを支持する傾向があるのに対し、自然な誤りは 1 または 2 ビットを支持する傾向がある。より大きいビット数を有する訂正を選択することによって、良い訂正よりも誤訂正を選択する確率が極めて高くなる。

【0050】

次のセクションは第 4 のボックス、図 15 の訂正不能符号語の試行を説明する。このアルゴリズムは、信頼できない訂正を除き、以前には訂正不能であったオフセットのみに焦点を当てること以外は EDC 訂正アルゴリズムに類似する。このエンティティに誤訂正がない（すなわち全ての「信頼できない」訂正が信頼できる）場合、このアルゴリズムはしばしば成功する。このアルゴリズムに問題を起し得る他の条件は、2 つの訂正不能な符号語が全てのデータブロックにおいて衝突する破損を有する場合である。この状態では、EDC は 2 つ以上の符号語の混合体を有し、いかなる特定の符号語からも正しい値を分離す

10

20

30

40

50

ることが不可能となる。

【0051】

図26は、全ての(以前には)訂正不能な符号語を訂正するよう試みるためのアルゴリズム260を示す。第1のステップ262は、訂正不能な符号語のための衝突マップを計算する。このマップは全てのエンティティについて一定であって、各符号語の性質を特定するためのガイドを与える。次にアルゴリズムは、不良なEDCを有する全てのデータブロックを通ってループする。各ブロックについて、装置は、1)衝突のない符号語を扱う、2)衝突を有する符号語を扱う、という2つのアルゴリズムの各々を試みる。これら2つのアルゴリズムのいずれかが良いCRCを有するブロックを見つけると、図26のアルゴリズムは成功264に戻る。図15のアルゴリズムは次に、装置が反復的訂正のために十分なマージンを有するか否かを検査し、装置が十分なマージンを有しない場合には最初から続ける。

10

【0052】

次の2つのセクションは、図26の2つの副アルゴリズムを説明する。第1のセクションは、図26の「衝突のない符号語の訂正」266とラベルをつけられたボックスを説明する。衝突がないので、このアルゴリズムは多くても4つの処理すべき符号語を有する。この制限が4であるのは、32ビットのEDC残余に、4バイトを超えて独立に適合させることは不可能だからである。衝突を有する符号語と別個にこれらの符号語を処理することが効率的であるのは、これらの符号語がブロック内で値を変えないからである。逆に、衝突を有する符号語はいくつかのあり得る値を有する。

20

【0053】

このアルゴリズムの第1のステップは、衝突マップ(Collision Map)、完成マップ(Complete Map)、およびEDC残余(EDC Residual)を用いて、このアルゴリズムが所望の結果を生成することができるかどうかを判断することである。プロセスの1つの変形例が以下に詳細に記載される：

30

1. EDC残余がゼロであり、CRC検査が失敗した場合、装置はこのブロックを処理することができない。次のブロックへ進む；

2. EDC Residual AND NOT Complete Mapを計算する(すなわち、C表記でEDC & ~Complete Map)。この結果が非ゼロである場合、訂正不能な符号語のいずれもが影響を及ぼすことができないビットがEDC残余内にある。この場合、装置はこのブロック全体をスキップする。符号語のうち1つに誤訂正があった；

3. 前の検査が成功した場合、装置は次に、衝突のない符号語に対応する非ゼロのビットがEDC残余内にあるか否かを見る。装置は、「EDC Residual AND NOT Collision Map」(すなわちCにおけるEDC & ~Collision Map)としてこれを計算することができる。この結果がゼロである場合、装置は次に衝突を有する訂正不能な符号語を扱うためのアルゴリズムにスキップする。そうでなければ、装置はこのアルゴリズムを続ける。

40

【0054】

前の検査が成功した場合、装置は次に衝突マップ外でEDC残余の一部に影響を及ぼす訂正不能な符号語について検索する。装置がこのような符号語を見つけた場合、装置は衝突マップと一致しない符号語の一部を訂正する。この符号語は、誤り値としてEDC残余を用いる。

【0055】

第2のセクションは、衝突を有する訂正不能な符号語の組合せを全数的に選択することによって訂正を試みるアルゴリズム270を説明する。図27は、アルゴリズムを概説する。

【0056】

一般的な概念は、このアルゴリズムを用いて従属的な訂正不能な符号語の全ての組合せを試みることである。しかしながら、このアルゴリズムが盲目的に全ての組合せを試みる

50

とすると、極めて多数の可能性があり得ることとなる。特に3つの消失があるフォーマットの場合にそうである。この場合、全ての破損が訂正不能であり、潜在的に多数の組合せがある。推定される組合せの最大値は、 $16^4 = 64K$ である。装置が各データブロックについてこれを行う場合、100万の異なる可能性があり得る。これには数秒または数分もかかり、装置の再試行はその間によりうまく行われる。

【0057】

あらゆる組合せを試みる代わりに、このアルゴリズムはそれ自体を合理的な可能性の領域に限定する。第1のアルゴリズムは、あらゆる組合せを試みる前に、まず各符号語に注目し、シンドロームを用いて結果をクロスチェックする。訂正試行が合理的に見えた場合、装置は符号語を有用とマークする。このクロスチェックは、間違った選択肢のうち少なくとも90%、恐らく99%を除去する。

10

【0058】

シンドロームを修正するための式は次の通りである。

$$S_j = S_j + X^j Y \quad (X)$$

この式において、 S_j は第 j の新しいシンドローム、 S_j は現在のシンドローム、 X は現在のブロックの位置、 Y はE D Cの誤りパターンであって、 (X) は X において評価された消失位置多項式である。変数 j は0から(E C C B l o c k s - E r a s u r e s - 1)である。

20

【0059】

良いクロスチェックを用いて全ての符号語を見つけた後、装置はこれらの符号語がE D C残余の非ゼロ領域の完全なカバレージを有するか否かを再確認することができる。装置は、これらの符号語について全てのE D Cマップの論理和を計算し、次にE D C残余を用いて論理積演算を実行することによって、このカバレージを決定する。この結果が非ゼロである場合、装置はこのブロックを訂正するのに充分なカバレージを有しない。この場合、装置は次のブロックにスキップする。

20

【0060】

装置が完全なカバレージを有する場合、次のステップは、全零のE D C残余を残す独立した符号語の全ての組合せを試みることである。E D C残余がゼロになる場合、装置はこのブロックを最終的に確認するためにC R C検査を試みることができる。単純な再帰的アルゴリズムは、符号語を確認しながら前の符号語から独立している新しい符号語を選択することによって、これらの組合せを見つけることができる。

30

【0061】

下記のセクションでは、32ビットのE D C(誤り検出符号)およびこの符号がエンティティ訂正アルゴリズムにいかに役立つことができるかを説明する。E D Cは、データブロック内のユーザデータ領域を保護する、32ビットの誤り検出符号である。E C Cブロックは有効なE D Cフィールドを含まない点に注意されたい。

30

【0062】

下記のセクションでは、E D C、E D Cマップの特性を説明し、次にE D C訂正アルゴリズムに及ぶ。要するに、E D Cマップは、破損した符号語をE D C残余の対応するセクションに接続する方法である。それはE D Cおよび全数訂正アルゴリズムにおいて用いられる。計算されたE D C残余は誤りパターンのみに依存し、良いデータには依存しない。さらに、E D Cは線形である。

40

【0063】

E D C計算は、リードソロモン符号またはC R C検査(または他のB C H符号)によって用いられる計算と同様の、ガロア体の計算を用いる。

【0064】

E D Cは32ビット記号を用い、G F(2^{32})のリードソロモン符号(32ビットのガロア体)と同様である。このガロア体のための定義多項式 $P(x)$ は次の通りである。

【0065】

$$P(x) = x^{32} + 1 = (x + 1)^{32}$$

50

$G F (2^{32})$ における原始元 は、
 $= (00000000.00000000.00000000.00000010)$ (2進法)

である。

【0066】

標準リードソロモン符号とは異なり、この符号はその計算に原始多項式を用いない。事実、ガロア体のサイズは、完全な $2^{32} - 1$ ではなく、32元のみである。

【0067】

この原始多項式は、ハードウェアおよびファームウェアにおいて非常に使いやすい。なぜならば による乗算は、1ビットの左ローテーションと等価だからである。事実、^N を乗算することは N ビットの左ローテーション ($m o d 32$) と同じである。

10

【0068】

EDC は、次のような生成多項式 $G(x)$ を有する。

$$G(x) = x +$$

この例では、生成多項式は非常に単純な形式を取る。しかしながら、別のアルゴリズムが誤り位置を決定することができる場合、EDC は単一の 32 ビット記号を訂正することができる。これは全数訂正アルゴリズムにおいて用いられる重要な機能である。図 28 は、EDC ジェネレータ / チェック回路 280 の表示である。

【0069】

上記のダイヤグラムにおいて、プラスのついた円はガロア体加算を示し、それはビットワイズ X OR (排他論理和) 演算の等価物である。のついた円はガロア体乗算演算であって、この場合 1 ビットの左ローテーション演算と同じである。「EDC」とラベルのついたボックスは、EDC 残余を保持する 32 ビットレジスタである。EDC 計算を始める前に、ハードウェア (またはファームウェア) は「EDC」レジスタをすべて 1 に初期化する。初期化後、ハードウェアは全てのデータを順に回路に入れる。ハードウェアは、各クロックサイクルにおいて、データの 1 つの 32 ビット語を処理する。

20

【0070】

EDC 演算は、リードソロモン符号と同じく線形である。この特性は、それにより良いデータを無視して誤りパターンのみに焦点を当てることができるので、有用である。ここでこれがいかに作用するかを説明する。

【0071】

$m(x)$ がメッセージまたはオリジナルデータであるとする。 $e(x)$ が誤りパターンである。これらの各々が多項式であって、そこでデータまたは誤りパターンは、多項式内の各項の係数である 32 ビット語である。最初の 32 ビット語は x の最大幂乗の係数であり、最後の 32 ビット語は定数項 (すなわち x^0 の係数) である。

30

【0072】

受取ったデータ $r(x)$ は、メッセージを誤りパターンに加算した結果である。

$$r(x) = m(x) + e(x)$$

EDC ($f(x)$) はデータストリーム $f(x)$ 上で EDC 残余を計算する演算であるとする。EDC 計算は、下記の式が有する性質を示す。

【0073】

$$EDC(f(x)) = f(x) \bmod (x + \quad) = f(\quad)$$

40

これは、EDC 残余が、 $x = \quad$ における入力多項式の評価と同じであることを意味する。データが良い場合、EDC 残余はゼロである。すなわち、

$$EDC(m(x)) = m(\quad) = 0$$

となる。

【0074】

装置が受取ったデータの EDC を次に計算する場合、装置は以下を得る。

$$EDC(r(x)) = r(\quad) = m(\quad) + e(\quad)$$

$m(\quad) = 0$ を $EDC(r(x)) = m(\quad) + e(\quad)$ に代入すると、装置は、

$$EDC(r(x)) = e(\quad)$$

50

を得る。

【0075】

これが意味することは、装置が良いデータを無視して誤りパターンにのみ焦点を当てる
ことができるということである。すなわち、EDC残余内のいかなる1も誤りパターンの
直接の結果であって、良いデータから独立している。

【0076】

この例では、EDC計算は、データがEDC計算の前にスワップされるか、または後に
されるかに依存しない。ポリシープロセッサは、スワップされた順にキャッシュからデー
タを読み取る。この文脈においてスワップとは、32ビットデータ語内で、高位の16ビット
をより低位の16ビットに交換することを指す。これは、EDC結果の単一のスワップ
とは反対に、全データ語におけるスワップを避けることによって計算が省力化される。この
特性を要約する式は以下の通りである。
10

【0077】

$$EDC(SWAP(Data)) = SWAP(EDC(Data))$$

これが当てはまるのは、16ビットのスワップ演算が16ビットの左ローテーションと
等価であり、ガロア体の計算が線形だからである。EDCのガロア体において、スワップ
は¹⁶による乗算に等しい。ガロア体の計算においては、ユーザデータを、各データ点を
各項の係数として多項式として表示するのが便利である。ここで、N個の32ビットのデ
ータ語があると仮定して、データストリームm(x)を表示する式がある：

【0078】

【数1】

$$m(x) = D_0x^{N-1} + D_1x^{N-2} + \dots + D_{N-2}x + D_{N-1}$$

【0079】

ここで、 $D_{0..N-1}$ はユーザデータストリームである。

装置が全てのデータをスワップする場合、メッセージデータは以下のようになる。

【0080】

【数2】

$$m_{swap}(x) = \alpha^{16}D_0x^{N-1} + \alpha^{16}D_1x^{N-2} + \dots + \alpha^{16}D_{N-2}x + \alpha^{16}D_{N-1}$$

【0081】

ガロア体の計算は分配法則に従い、それは $a b + a c = a(b + c)$ とする。この法則を
用いて、装置は次のように¹⁶因のすべての因数を集めることができる。

【0082】

【数3】

$$m_{swap}(x) = \alpha^{16}(D_0x^{N-1} + D_1x^{N-2} + \dots + D_{N-2}x + D_{N-1}) = \alpha^{16}m(x)$$

【0083】

データストリームのEDC残余は、 $m(x)$ を $(x + \alpha)$ で除算した後の剰余と等価で
ある。これは、評価 $m(\alpha)$ と等価である。スワップされたデータストリームのEDCを
得た結果は次の通りである。
40

【0084】

【数4】

$$EDC(m_{swap}(x)) = m_{swap}(\alpha) = \alpha^{16}m(\alpha) = SWAP(EDC(m(x)))$$

【0085】

要約すると、EDC残余をスワップする限り、データストリームの各語をスワップする
必要はない。また、ポリシープロセッサにとってスワップされた残余がより便利なので
、下記に記載されるEDCマップは全てスワップされたバージョンのEDC残余を用いる
ことにも注意されたい。これが適用されるのは、全てのマップが一貫したスワップされる
50

順序を有するからである。

【0086】

EDCマップ(EDCマスクとも呼ばれる)は、特定の符号語とEDC残余の対応する領域との関連をマッピングするために用いられる構成である。このマッピングは、EDC残余が信頼できるか否かを判断するのを助け、全数訂正アルゴリズムのために有用である。誤りがいかにEDC残余に影響を及ぼすかを示す例は以下に記載される。まず、ブロック内で1バイトの誤りを有するEDC残余がいかなるものかを示す例が下記に説明される。

【0087】

第10の32ビット語に以下の誤りパターンEがあるとすると、

$$E = 00000000.00000000.00000000.11100111$$

である。

【0088】

この誤りパターンは、最初の3バイトには良いデータ、最後のバイトには破損データを表示する。EDCが線形であるので、装置は良いデータを完全に無視することができ、誤りパターンだけに焦点を当てることができる。全ての良いデータはゼロに等しいと仮定することができる。たとえば、100個の32ビット語がEDC保護された領域内にあると仮定すると、結果として生じるEDC残余を決定するために、装置は、全零のシードだけを用いて、単一の誤りパターン上でのみEDCを計算することを想定し得る。この例では、シードが全零であり、データが全零なので、最初の9個の演算は何もしない。装置が第10の語を処理するときに、EDCは誤りパターンEを含む。この時点以降、EDC計算は全零の語の処理を続ける。全零の語はEDCに影響を及ぼさないので、唯一生じるのは、誤りパターンがあらゆる新しい語について1ビットの左ローテーションを続けることである。装置が最終的に最後の語に達するとき、装置はEDC値において $100 - 10 = 90$ のローテーションを実行している。32ビットの巡回ローテーションが元の値を与えるので、装置は、ローテーション数 $m \bmod 32$ (すなわち32で乗算した剰余)のみを見ればよい。

【0089】

$$\text{ローテーション} = 90 \bmod 32 = 26$$

したがって、結果としてのEDC残余は、26ビットだけ左ローテーションした誤りパターンEである。以下が結果である。

【0090】

$$EDC = 10011100.00000000.00000000.00000011$$

装置が別の手段(例えば拡大訂正からの失敗した符号語)によって、破損したバイトの位置を特定することが可能な場合、装置は、EDC残余を26ビットだけ右ローテーションをさせ、次にこの値を第10の32ビット語で排他的論理和をとることにより訂正を実行することができる。これがEDC訂正アルゴリズムの奥にある概念である。

【0091】

エンティティ内の各バイト幅の符号語は、EDC残余内のビットの特定の組を変える能力しか有さない。これが当てはまるのは、循環ローテーション演算が32ビット語にわたってパターンを広げないからである。その代わり、循環ローテーションは元のビットを合わせて維持し、単にその位置を変える。この特性のために、符号語によって恐らく影響を受けるであろう32ビット語の領域、および符号語の相対的なエンティティオフセットを決定しさえすればよい。

【0092】

上記の例において、装置は第10の語の最終バイトが何らかの破損を有することを知っている。しかし装置は、誤りパターンが何であるかについてはまだわからない。装置は、誤りが最終バイト内でビットに影響を及ぼすが、語の他の3つのバイトには影響を及ぼさないことを特定しただけである。装置はこの情報を用いて下記のパターンを有するEDCマスクを生成することができる。

10

20

30

40

50

【0093】

M a s k = 00000000.00000000.00000000.11111111

このマスクは、ビットが誤りパターンに依存し得ることを示すために2進法の「1」を用い、ビットが誤りパターンから独立していることを示すために2進法の「0」を用いる。この規則によって、正しいローテーションを用いて、全てのE D Cマスク間で論理和演算を実行することによって、影響を受け得る全てのビットを見つけることが可能である。

【0094】

E D Cマップアルゴリズムは、全てのE D Cマスクおよび残余を中立位置までローテーションさせ、これは定義上、オフセットゼロのためのローテーションである。この例において、このマスクが語10にあるので、装置はマスクを10ビットだけ右ローテーションさせることによってマスクを「正規化」することが必要である。正規化されたマスクは以下の通りである。

10

20

30

40

50

【0095】

M a s k = 00111111.11000000.00000000.00000000

このマスクをE D C残余と比較するために、装置はE D C残余を100ビットだけ右ローテーションさせることによって正規化する必要がある。なぜならば以前の例で、E D Cを語100に配置したからである。第32、第64、および第96のローテーションは全て残余をもとの位置に戻し、そのため装置は残余を $100 - 96 = 4$ ビットだけ右へ動かせばよいだけである。ここで結果として生じるE D C残余がどのようになるか、例として、E D C = 10011100.00000000.00000000.00000011を用いて示す。

20

【0096】

E D C = 00111001.11000000.00000000.00000000

E D C = 00111001.11000000.00000000.00000000から正規化されたE D C残余が、M a s k = 00111111.11000000.00000000.00000000からのマスクと一致することに注意されたい。これが、装置がE D Cマスク（またはE D Cマップ）をE D C残余に関連づけるやり方である。装置は、以前の右ローテーションと同じ回数だけ左ローテーション演算を実行することによって、これらの正規化されたバージョンをもとのバージョンに戻すよう関連づけることができる。

【0097】

2つ以上の破損した符号語がE D C残余内の同じビットに影響を及ぼすことが果たして可能か否かについて判断することは有用である。影響を及ぼせる場合、2つの破損した符号語が互いをキャンセルすることが可能であり、それらは検出されないまま残る。この可能性がある場合、装置はもはやE D Cが確実に誤りを検出するとは当てにできず、より強力な誤り検出符号、例えばC R C 6 4に切り替えなければならない。衝突もE D C訂正アルゴリズムに影響を及ぼす。なぜならば、装置は、E D C残余の一部を特定の符号語に直接適用する代わりに、訂正試行の複数の組合せを用いなければならないからである。

30

【0098】

例えば、エンティティがちょうど拡大訂正を終えても、依然2つの信頼できない（または訂正不能な）符号語を有する。簡潔にするため、フォーマットがレガシテープフォーマット（すなわちクウォンタムS D L T 6 0 0 フォーマット）であり、5個の部分的に回復されたブロックおよび15個の良いブロックがあると仮定する。符号語はそれぞれバイトオフセット100および200にある。図29は、このシナリオを示すダイヤグラム290である。

40

【0099】

図29において、「？」は未知の性質を有するバイトを示す。これらは、訂正不能な符号語の結果であるか、または誤った訂正をされた符号語のあり得る結果である。各符号語内どのバイトが良く、または不良なのかを判断するのは困難である。エンティティ内の他のバイトは全て良い。

【0100】

これらの2つの符号語がE D C残余の異なる部分に対応する場合、これらの符号語の両

50

方を訂正するために E D C 残余を用いることが可能である。その上、これらの符号語が独立している場合、装置は破損を特定するために E D C に依存することができる。これらの符号語両方のための E D C マップ 3 0 0 が図 3 0 に示される。

【 0 1 0 1 】

2 つの符号語の各々については、装置は最初の E D C マップ 3 3 2 を生成することから始める。このマップは、3 2 ビット語内の符号語の位置に依存する。それは、バイト 0 、 1 、 2 または 3 のいずれかに影響を及ぼし得る。この場合、符号語 1 0 0 および 2 0 0 は両方ともバイト 0 に影響を及ぼす ($100 \bmod 4 = 0$ 、および $200 \bmod 4 = 0$) 。例えば S D L T のビッグエンディアンシステムなどのシステムにおいて、バイト 0 は最上位の 8 ビットを占めるので、両方のマップは 8 個の最上位ビットの 1 から始める。次に装置は E D C マップを正規化する。これは、最初の E D C マップ 3 3 2 をワードオフセットだけ右ローテーションすることによって作用する。符号語 1 0 0 および 2 0 0 のワードオフセットは、それぞれ 2 5 および 5 0 である。これは、3 2 ビット語につき 4 バイトがあるという事実による ($100 / 4 = 25$ および $200 / 4 = 50$) 。

【 0 1 0 2 】

衝突マップ 3 3 6 は、全ての正規化された E D C マップ 3 3 4 の中の重なり合う領域である。これは、2 つの符号語の場合、2 つのマップの論理積である。図 3 0 に示すように、衝突マップ 3 3 6 はビット 6 にただ 1 つの 1 を有し、非ゼロである。結果として、装置は E D C 残余のビット 6 を信頼することができない。それは重要な衝突ではないが十分であるので、装置はロック確認のために C R C 検査まで遷移する必要がある。完成マップ 3 3 8 は、E D C 内の全ての影響を受けたビットを示す。これは個々の E D C マップ全ての単純な論理和である。このマップは、一般的な場合に衝突を見つけるとき、3 個以上の信頼できない符号語があり得るときに必要である。衝突を見つけるためには、装置は新しい正規化された各 E D C マップを現在の完成マップと比較する。いずれかのビットが重なる場合、装置はそれらを衝突マップに加える。

【 0 1 0 3 】

本発明が記載され、本発明の具体例が描写された。本発明が特定の変形例および示した図に関して記載される一方、当業者は、本発明が記載された変形例または図面に限定されないことを認識する。加えて、上述の方法およびステップがある順序で発生するある事象を示す場合、当業者はそのステップの順序が変更されてもよく、そのような変更が本発明の変形例に従っていることを認識する。さらに、ステップのいくつかは、可能な場合に並列のプロセスで並行して実行されてもよく、上述のように連続して実行されてもよい。したがって、本発明の変形例があり、請求項に示される本発明の開示または等価物の精神の範囲内で、この特許が同様にそれらの変形例を含むことが意図される。最後に、本願明細書において引用される全ての公報及び特許出願は、個々の刊行物または特許出願が本願明細書において特別かつ個別に出されたかのように、それら全体が本願明細書において引用にて援用される。

【 図面の簡単な説明 】

【 0 1 0 4 】

【 図 1 】誤り検出装置が磁気テープドライブ用コントローラーの一部である、誤り検出装置の1つの実現例を示す図である。

【 図 2 】テープドライブ用のデータロックのレイアウトの例を示す図である。

【 図 3 】 E D C を計算するためのアルゴリズムを例示する図である。

【 図 4 】 E C C ブロックのレイアウトの例を示す図である。

【 図 5 】 B R C (後方読み取り互換性) フォーマットためのデータおよび E C C ブロックのレイアウトを示す図である。

【 図 6 】エンティティのレイアウトの例を示す図である。

【 図 7 】エンベロープのレイアウトの例を示す図である。

【 図 8 】後方互換性を有するフォーマットの1つのための典型的なエンベロープのレイアウトを示す図である。

10

20

30

40

50

【図9】後方互換性を有するフォーマットである別のエンベロープのレイアウトを示す図である。

【図10】読み取りアルゴリズムの例を示す図である。

【図11】全体的な訂正プロセスを示す図である。

【図12】訂正タイプの決定のプロセスを示す図ある。

【図13】消失訂正アルゴリズムの例を示す図である。

【図14】拡大訂正アルゴリズムの例を示す図である。

【図15】全数訂正アルゴリズムの例を示す図である。

【図16】符号語の信頼できる部分を処理するためのアルゴリズムの例を示す図である。

【図17】EDC訂正のためのセットアップの例を示す図である。 10

【図18】拡大訂正の結果を示す図である。

【図19】信頼できない符号語マップを示すテーブルを示す図である。

【図20】信頼できる符号語および良いブロックを削除した後のエンティティを示す図である。

【図21】符号語AおよびFのためのEDCマップを示す図である。

【図22】EDC残余における誤りパターンの効果を示す例を示す図である。

【図23】最終訂正語の生成の例を示す図である。

【図24】信頼できない符号語の試用のためのアルゴリズムの例を示す図である。

【図25】バイト内の所与の1の個数についての確率分布の例を示すダイヤグラムである。 20

【図26】訂正不能な符号語の試用のためのアルゴリズムの例を示す図である。

【図27】衝突を有する訂正不能な符号語の試用のためのアルゴリズムの例を示す図である。

【図28】EDCジェネレータ/チェック回路の例を示す図である。

【図29】2つの信頼できない符号語を有するエンティティを示す図である。

【図30】衝突マップの生成の例を示す図である。

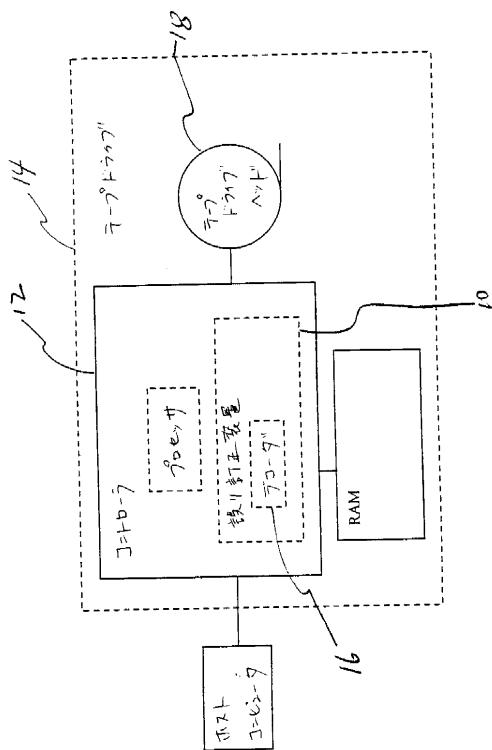
【符号の説明】

【0105】

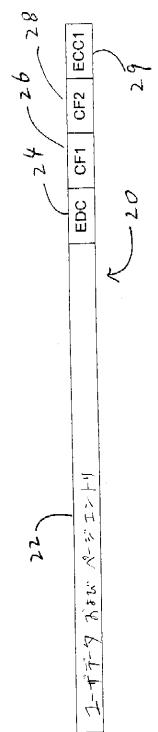
332 EDCマップ、 334 正規化されたマップ、 336 衝突マップ、 33

8 完成マップ。 30

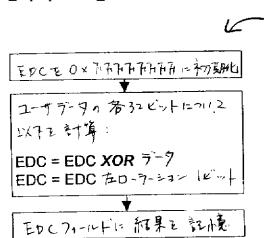
【図1】



【図2】



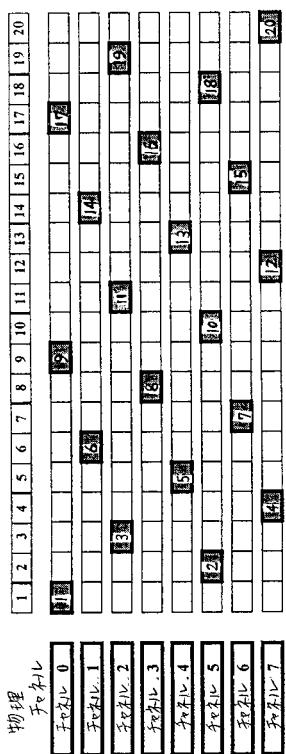
【図3】



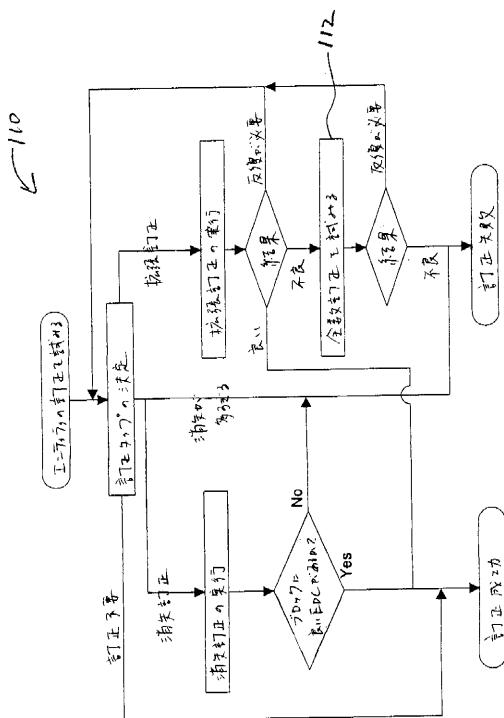
【図4】



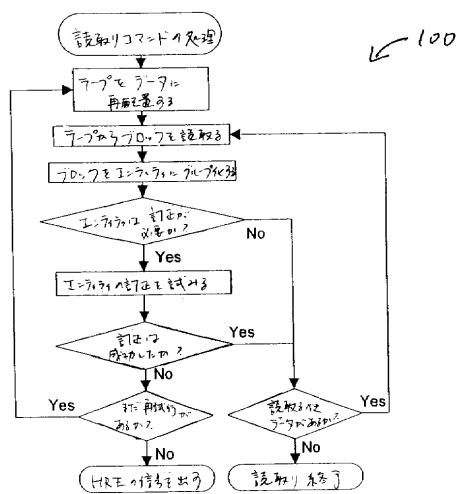
【 四 9 】



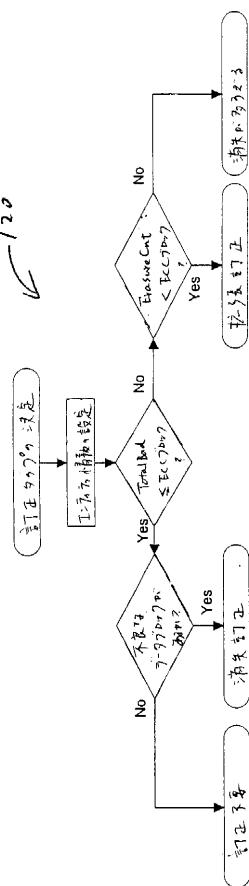
【 図 1 1 】



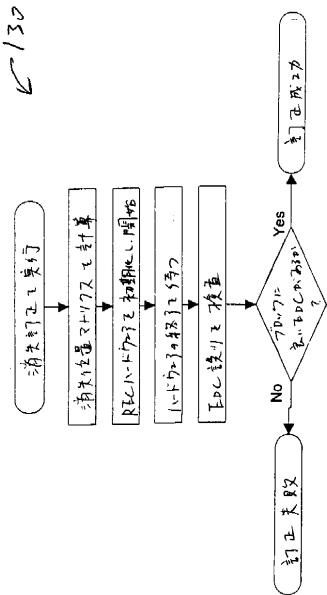
【 図 1 0 】



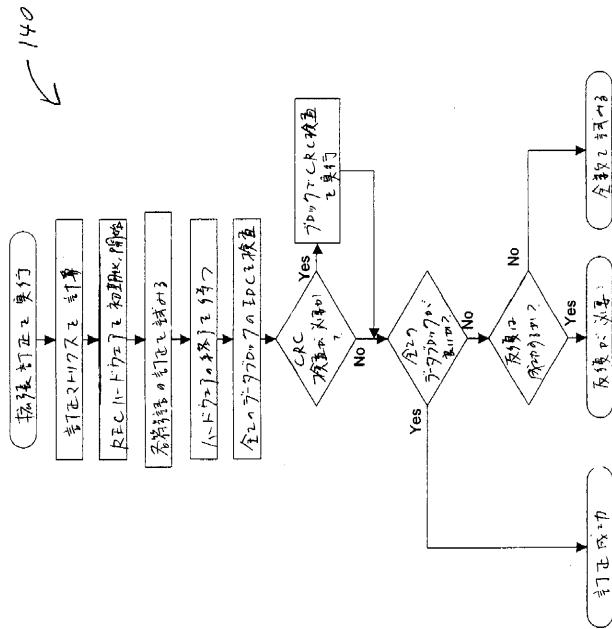
【図12】



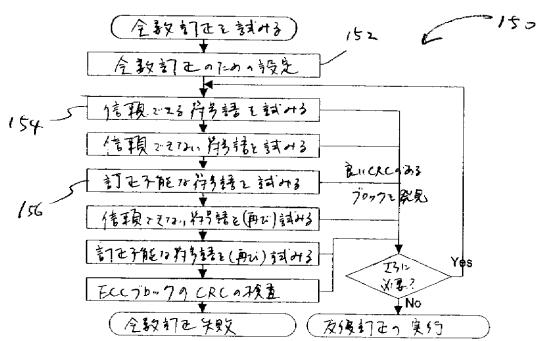
【図 13】



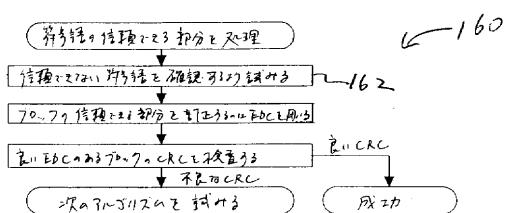
【図 14】



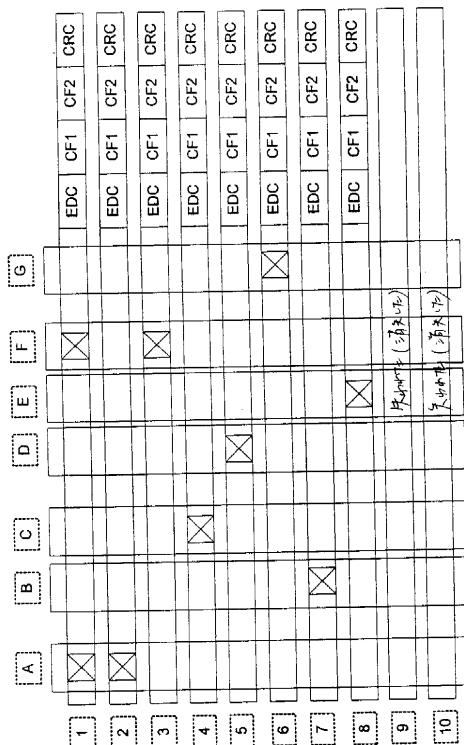
【図 15】



【図 16】



【図 17】



【図18】

↙ 180

	EPC(100)					
	A		B		C	
	EPC	CF1	CF2	CRC	EDC	CF1
1	☒					
2		☒				
3			☒			
4				☒		
5					☒	
6						☒
7		☒				
8					☒	
9	☒					
10		☒				

☒ = 誤り正しくない
☒ = 誤り正しい
☒ = 破損(?)
□ = 良い

【図19】

↙ 190

	EPC(100)					
	A		B		C	
	EPC	CF1	CF2	CRC	EDC	CF1
1	☒					
2		☒				
3			☒			
4				☒		
5					☒	
6						☒
7		☒				
8					☒	
9	☒					
10		☒				

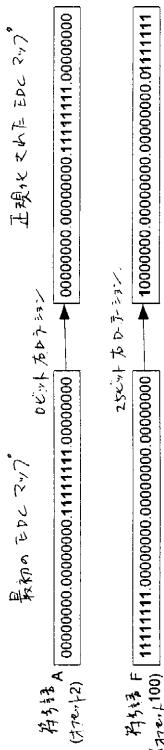
☒ = 誤り正しくない
☒ = 誤り正しい
☒ = 破損(?)
□ = 良い

【図20】

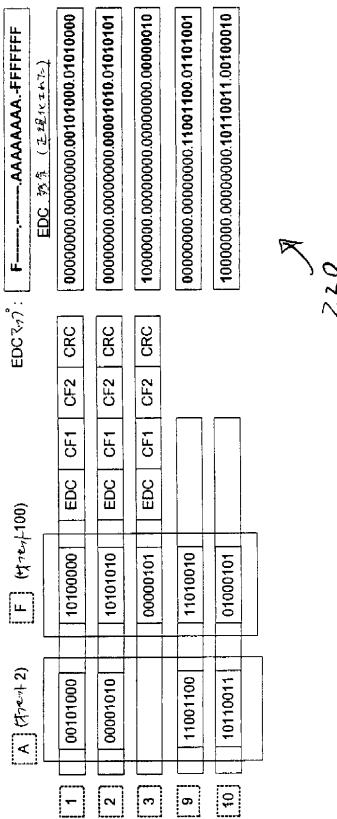
↙ 200

	F (100+12)					
	A		B		C	
	EPC	CF1	CF2	CRC	EDC	CF1
1	☒					
2		☒				
3			☒			
4				☒		
5					☒	
6						☒
7		☒				
8					☒	
9	☒					
10		☒				

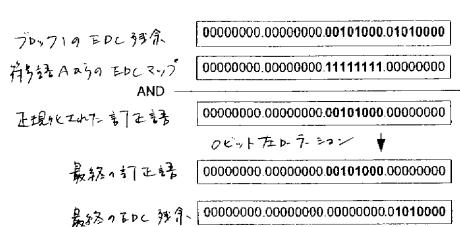
【図21】



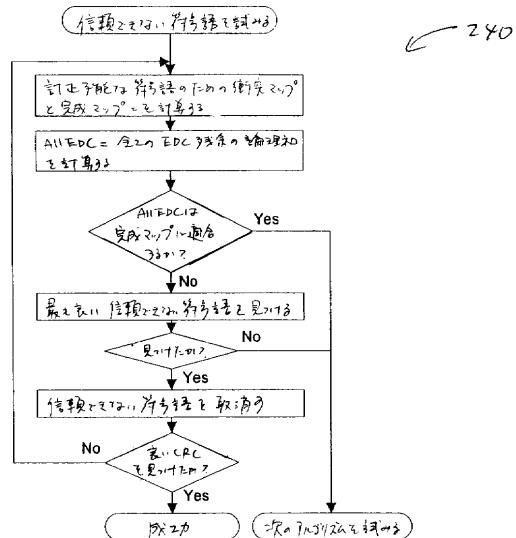
【 図 2 2 】



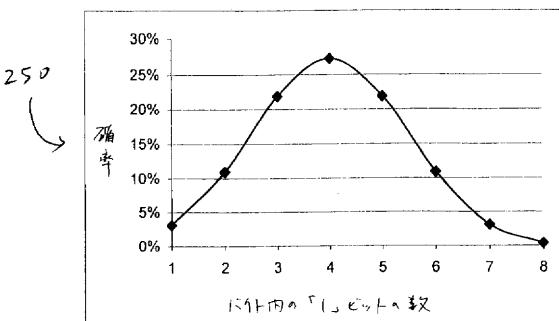
【 図 2 3 】



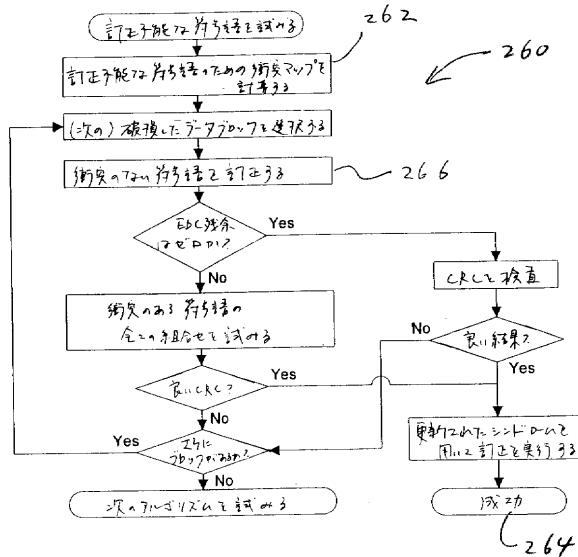
【 図 2 4 】



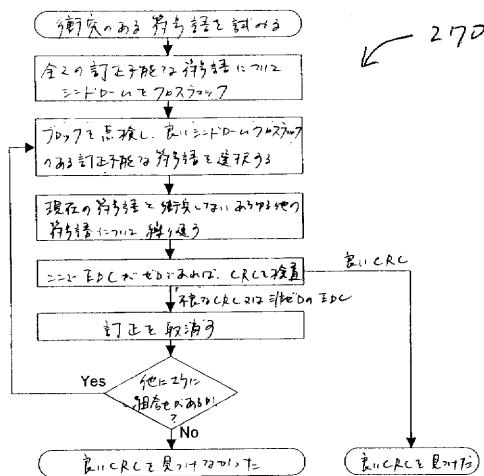
【図25】



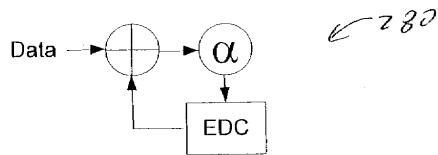
【 図 2 6 】



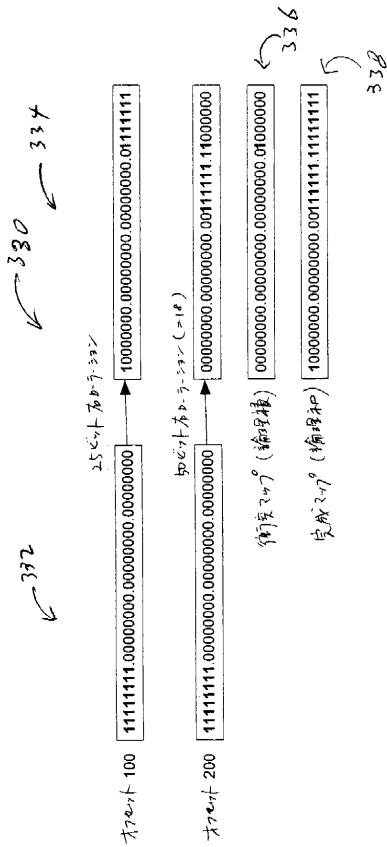
【 図 27 】



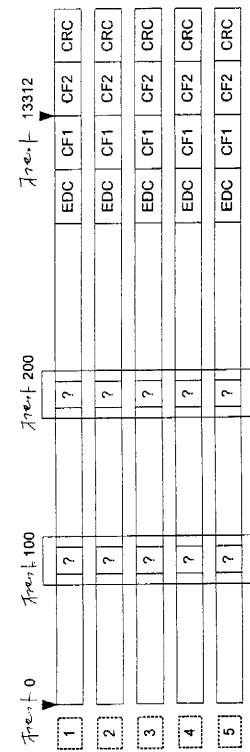
【図28】



【 図 3 0 】



【 図 29 】



フロントページの続き

(51)Int.Cl.

F I

テーマコード(参考)

G 11 B	20/18	5 7 2 F
G 11 B	20/18	5 7 2 B
G 11 B	20/18	5 7 2 C
G 11 B	20/18	5 3 6 C
G 11 B	20/18	5 3 6 D

(74)代理人 100098316

弁理士 野田 久登

(74)代理人 100109162

弁理士 酒井 將行

(72)発明者 マシュー・ブイ・ボール

アメリカ合衆国、80301 コロラド州、ボルダー、チザム・トレイル、3315、ナンバー・
204

F ターム(参考) 5J065 AC03 AD04 AD11 AH20